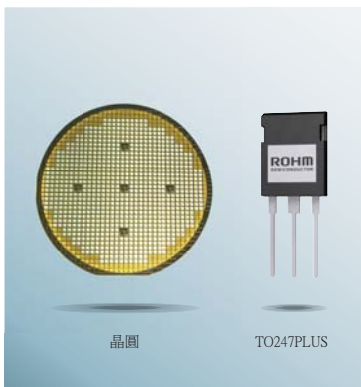


超低導通電阻/高耐壓型MOSFET

R5□□D系列

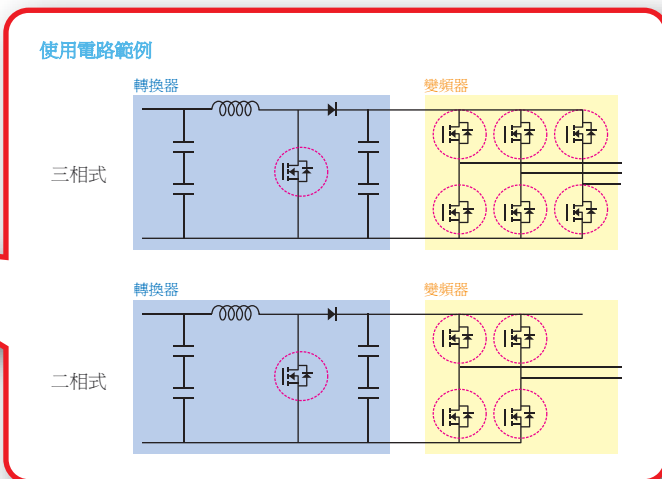
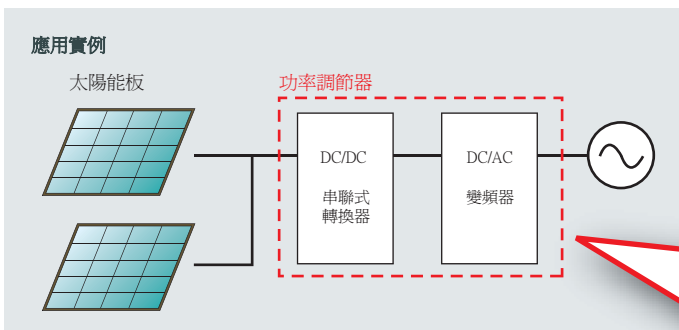
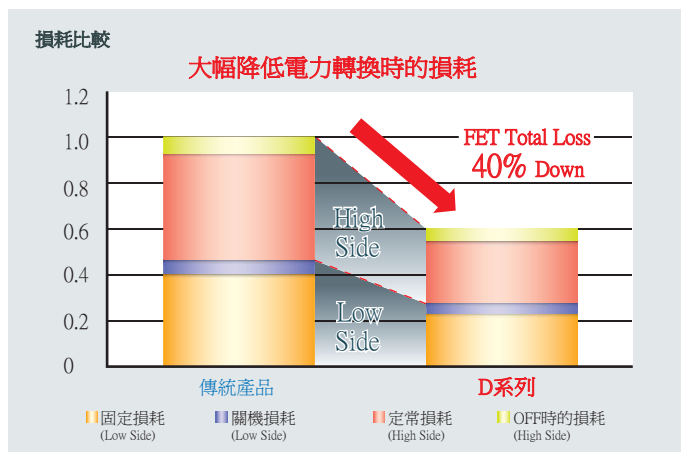
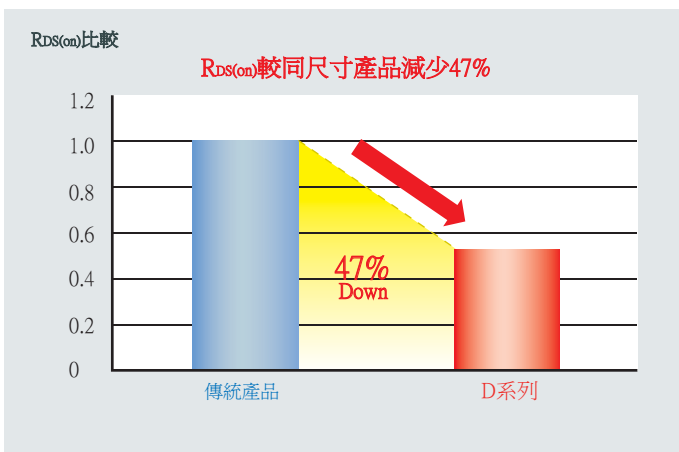


最適合太陽能發電系統的功率調節器(Power Conditioner)使用！採用矽深掘蝕刻技術的超接合(Super-junction) MOSFET

產品概要

ROHM運用獨創的矽深掘蝕刻技術，不但具備高耐壓特性，同時還能達到業界最高等級34 mΩ的低導通電阻。有效提高太陽能發電系統的功率調節器效率。

■ 超低導通電阻特性，讓功率調節器的轉換損耗更低



■ 產品陣容

Part No.	V _{DSS} (V)	I _D (A)	R _{DS(on)} typ.(mΩ) V _{GS} 10V	Q _g (nC) typ.
R5050DNZ0	500	50	34	80

本文件中所述的產品規格僅供參考。如需實際使用，請另行索取產品規格書。本文資料所引用的數據，皆為謹慎製作，以期達到正確無誤。若萬一因該數據的錯誤/誤植而引起客戶方面的損害，ROHM恕不負責。關於本資料所記載的技術資料，為產品的典型工作方式及應用電路範例，並不表示將原本屬於ROHM或其他公司的智慧財產權藉由銷售該產品明示地或默示地承認將使用權利轉移給購買者。因使用上述技術資料所發生的紛爭，ROHM恕不負責。本產品為特定機器・裝置所設計的產品，請務必確定該機器及裝置是否受到海關限制出口使用。

本文內容以2011年9月9日為準。

ROHM Co., Ltd.

台北：(02)2500-6956



www.rohm.com.tw